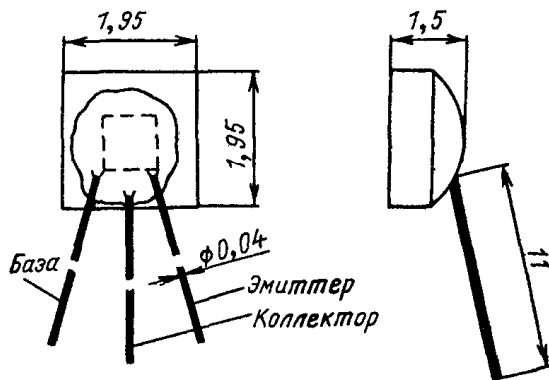


2Т388А-2, КТ388Б-2

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* универсальные высокочастотные маломощные. Предназначены для применения в импульсных, переключающих и усилительных высокочастотных схемах герметизированной аппаратуры.

Бескорпусные, на кристаллодержателе, с гибкими выводами, с защитным покрытием. Транзисторы поставляются в сопроводительной таре с возможностью измерения их параметров без извлечения из тары. Обозначение типа приводится на корпусе сопроводительной тары. Масса транзистора не более 0,02 г.



Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_K = 30$ мА не менее	250 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_Э = 30$ В, $f = 30$ МГц, типовое значение	60* пс
Время рассасывания при $I_K = 120$ мА, $I_{Б1} = I_{Б2} = 12$ мА не более	60 нс
Время выключения при $I_K = 120$ мА, $I_B = 12$ мА, типовое значение	75* нс
Время включения при $I_K = 120$ мА, $I_B = 12$ мА, типовое значение	30* нс
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 1$ В, $I_Э = 120$ мА	
при $T = 298$ К	25–100
при $T = 398$ К	25–200
при $T = 213$ К	10–100
Граничное напряжение при $I_Э = 10$ мА	50 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 120$ мА, $I_B = 12$ мА не более	0,6 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 120$ мА, $I_B = 12$ мА не более	1,2 В
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В, $f = 10$ МГц не более	7 пФ

Материал взят из источника:

Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В, $f = 10$ МГц не более	25 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 50$ В не более при $T = 298$ К	2 мкА
2Т388А-2	1 мкА
КТ388Б-2	10 мкА
при $T = 398$ К	
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 50$ В, $R_{БЭ} = 1$ кОм не более	2 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 4,5$ не более	2 мкА

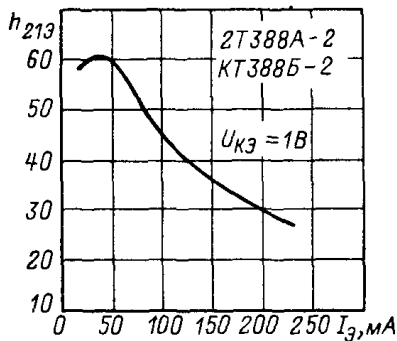
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	50 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 1$ кОм	50 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4,5 В
Постоянный ток коллектора	250 мА
Постоянная рассеиваемая мощность при $R_T \text{ п-х} = 183$ К/Вт: при $T \leq 353$ К	0,3 Вт
при $T = 398$ К	0,055 Вт
Температура перехода	408 К
Температура окружающей среды	От 213 до 398 К

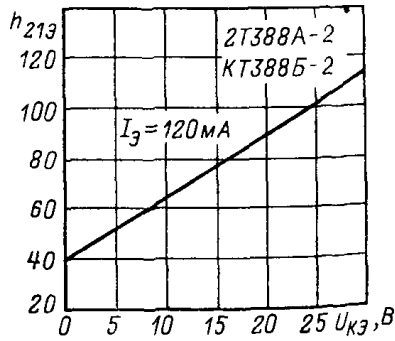
Примечание Минимальное расстояние от места пайки (сварки) вывода до поверхности транзистора 2 мм.

При монтаже должны быть приняты меры, исключающие изгиб выводов на расстоянии менее 0,5 мм от места выхода вывода из защитного покрытия, а также касание выводов и кристалла транзистора. При монтаже не допускается воздействие температуры более 473 К в течение 10 с.

В качестве покрытия транзисторов применяется лак ПАИ-1. При монтаже не допускается использование материалов, вступающих в химическое и электрохимическое взаимодействие с защитным покрытием и элементами конструкции транзистора.

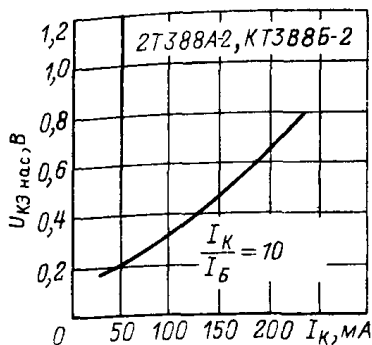


Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.

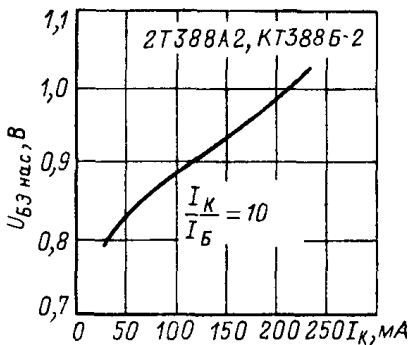


Зависимость статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер.

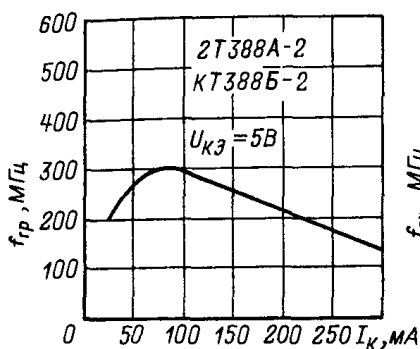
Материал взят из источника:



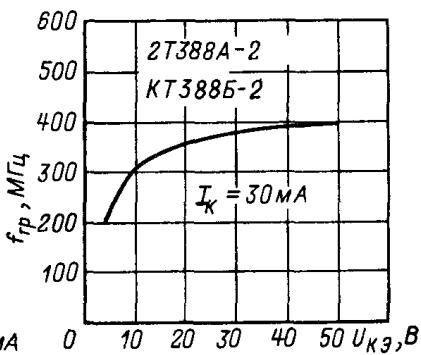
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора



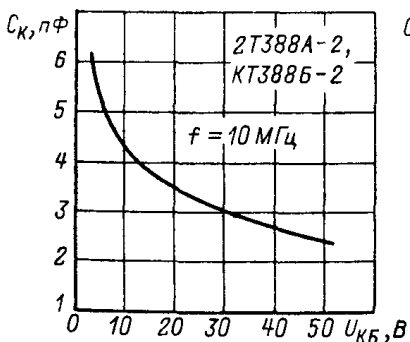
Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.



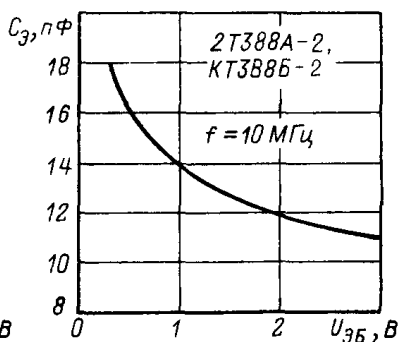
Зависимость граничной частоты от тока коллектора.



Зависимость граничной частоты от напряжения коллектор-эмиттер.



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база.



Зависимость емкости эмиттерного перехода от напряжения база-эмиттер.

Материал взят из источника: